

★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 国清辰也 副委員長 品田高宏
幹事 黒田理人・山口 直 幹事補佐 池田浩也

日時 11月10日(木) 10:00~16:40
11日(金) 10:00~16:30

会場 機械振興会館6階66号室(港区芝公園3-5-8. 東京メトロ日比谷線:神谷町駅下車徒歩10分, JR:浜松町駅下車徒歩20分, 都営地下鉄三田線:御成門駅・大江戸線:赤羽橋駅下車徒歩10分. http://www.jcmanet.or.jp/gaiyo/map_kaikan.htm TEL [03] 3434-8211)

議題 プロセス・デバイス・回路シミュレーション及び一般

10日午前

1. [招待講演] SISPAD 2016 レビュー(1) 園田賢一郎(ルネサス エレクトロニクス)
2. [招待講演] SiC トレンチ型 DMOS (TED MOS) のチャンネル特性に関する研究
○手賀直樹・久本 大・島 明生・嶋本泰洋(日立)

10日午後(13:30~)

3. [招待講演] Potential and Prospects of Low-Energy SOI Devices in Sensor Network Era
Yasuhisa Omura (Kansai Univ.)
4. [招待講演] フリーキャリア密度に依存した Ge のバンドギャップとフォノン周波数—半導体のバンドは本当に『リジッド』なのか?— ○株柳翔一・鳥海 明(東大)
5. [招待講演] ISFET の構造が感度に与える影響のシミュレーション 松澤一也(東芝)

11日午前

1. [招待講演] SISPAD 2016 レビュー(2) 鎌倉良成(阪大)
2. [招待講演] ワイドバンドギャップ半導体パワーデバイス開発に資するシミュレーション研究
望月和浩(産総研)

11日午後(13:30~)

3. [招待講演] チャージポンピング法による単一 MOS 界面トラップの個別検出と解析—原子スケールの視点で新たなトラップ物理を目指して— 土屋敏章(島根大)
4. [招待講演] 高品位 Si, Ge 基板の開発に資する第一原理計算—大口径結晶成長中の点欠陥制御から基板熱処理中の不純物ゲッタリングまで— 末岡浩治(岡山県立大)
5. ダブルゲート構造における自己無撞着モンテカルロシミュレーション
○坂本 萌・六郷泰昭・佐野伸行(筑波大)
6. a-Si pin 太陽電池の自己無撞着シミュレーションとキャリアの捕獲生成過程の物理機構
○鈴木 東(筑波大)・吉田勝尚(東大)・佐野伸行(筑波大)

◆応用物理学会共催

【問合先】

黒田理人(東北大)
TEL [022] 795-4833, FAX [022] 795-4834
E-mail: rihito.kuroda.e3@tohoku.ac.jp